



## Характеристики поликристаллического арсенида галлия

	Полуизолирующий арсенид галлия, нелегированный	Полупроводниковый арсенид галлия, дырочная и электронная проводимость
<b>Диаметр</b>	пластины: 0,5–4,25 дюйма слитки и синтез: 2–6 дюймов	
<b>Толщина</b>	пластины: 0,5–40 мм слитки и синтез: 50–100 мм	
<b>Легирующая примесь</b>	-	Цинк, кремний, теллур
<b>Концентрация носителей</b>	-	электронная проводимость: $1 \times 10^{16}$ – $2 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$ дырочная проводимость: $1 \times 10^{16}$ – $5 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$
<b>Удельное сопротивление</b>	$>1 \times 10^7 \text{ Ом} \cdot \text{см}$	$>1 \times 10^{-3} \text{ Ом} \cdot \text{см}$
<b>Холловская подвижность</b>	$>1 \times 10^3 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}^{-1}$	электронная проводимость: $>1500 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}^{-1}$ ; дырочная проводимость: низкая
<b>Плотность травления (EPD) ямок</b>	$<1 \times 10^4 \text{ см}^{-2}$	метод Чохральского с жидкостной герметизацией: $<7 \times 10^4 \text{ см}^{-2}$ метод вертикальной направленной кристаллизации: $<5 \times 10^3 \text{ см}^{-2}$
<b>Обработка поверхности</b>	пластины: резка / травление слитки и синтез: шлифование / выращивание / резка	
<b>Ориентация срезов</b>	по стандарту SEMI или EJ	
<b>Упаковка</b>	стандартная упаковка / Fluoroware / Fluoroware с герметизацией при помощи азота	